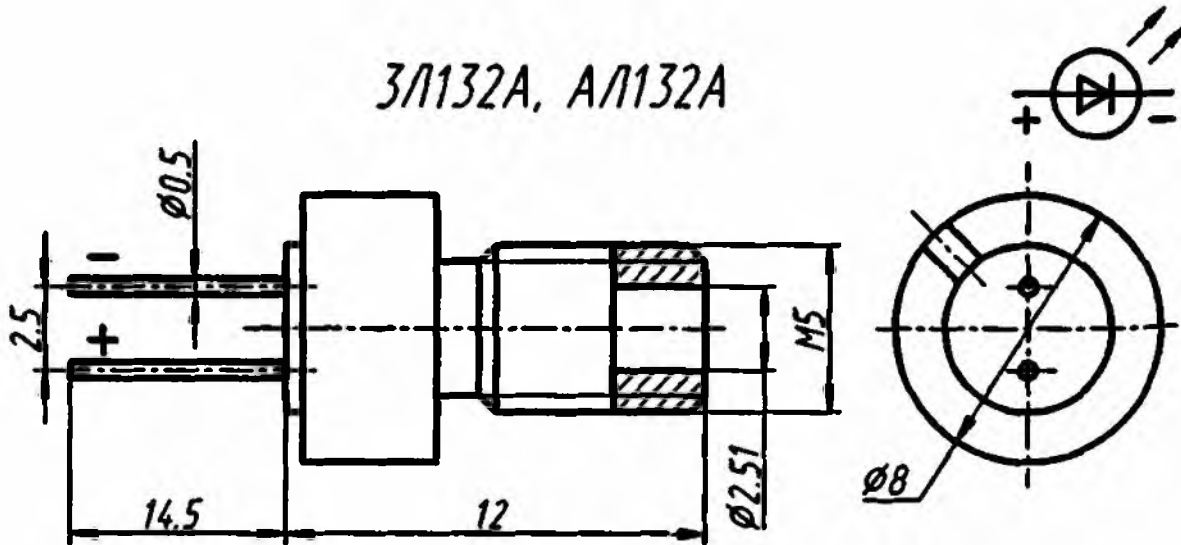


## ЗЛ132А, АЛ132А

Диоды излучающие, эпитаксиальные, на основе твердого расплава арсенида галлия—фосфида индия. Предназначены для использования в качестве источников ИК излучения в световодных системах связи и передачи информации. Выпускаются в металлическом корпусе. Тип диода приводится на корпусе.

Масса диода не более 5 г.



### Электрические и излучательные параметры

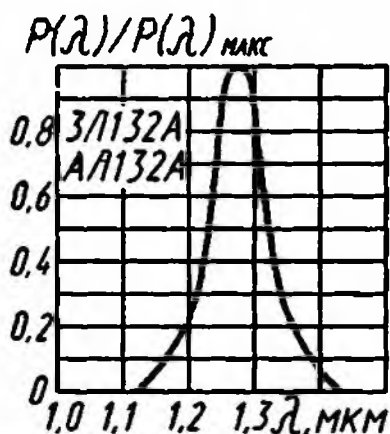
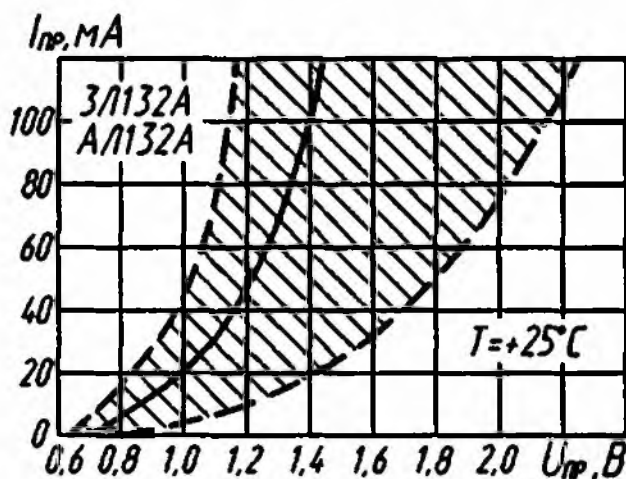
Мощность излучения при $I_{пр} = 50$ мА .....	10...19*... 75* мкВт
Длина волны максимума излучения* при $I_{пр} = 50$ А .....	1,2...1,27... 1,35 мкм
Время нарастания импульса излучения при $I_{пр} = 100$ А .....	4*...8*...20 нс
Время спада импульса излучения при $I_{пр} = 100$ А .....	4*...9*...20 нс
Постоянное прямое напряжение:	
при $I_{пр} = 50$ мА:	
$T = +25$ °С .....	0,91*...1,3*... 2 В
$T = -60$ °С, не более .....	3 В
при $I_{пр} = 20$ мА, $T = +85$ °С, не более .....	2 В

## Предельные эксплуатационные данные

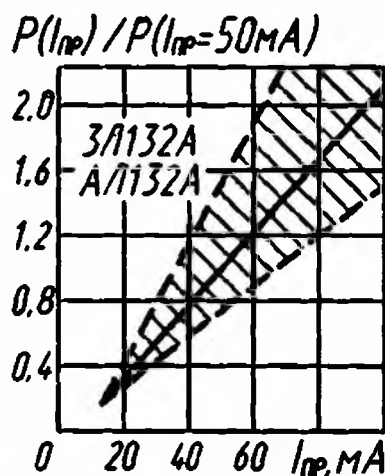
Постоянное (импульсное) обратное напряжение .....	1 В
Постоянный прямой ток:	
$-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq +35\text{ }^{\circ}\text{C}$ .....	50 мА
$T = +85\text{ }^{\circ}\text{C}^1$ .....	20 мА
Импульсный прямой ток при $I_{пр, ср} = 10\text{ мА}$ , $t_{и} = 15\text{ мкс}$ :	
$-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq +35\text{ }^{\circ}\text{C}$ .....	1 А
$T = +85\text{ }^{\circ}\text{C}^1$ .....	0,4 А
Температура окружающей среды .....	$-60...+85\text{ }^{\circ}\text{C}$

<sup>1</sup> В диапазоне температур окружающей среды  $+35...+85\text{ }^{\circ}\text{C}$  постоянный и импульсный прямые токи снижаются линейно.

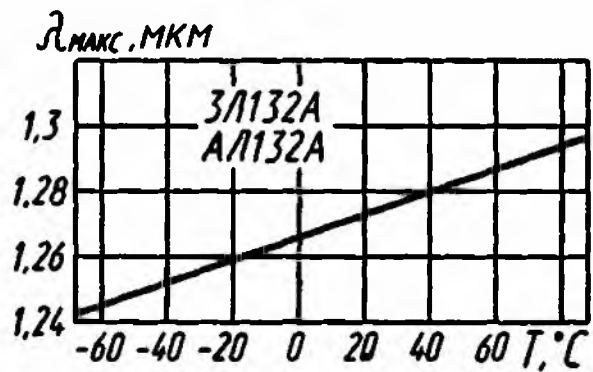
Зона возможных положений зависимости постоянного прямого тока от напряжения



Спектр излучения



Зона возможных положений зависимости относительной мощности излучения от постоянного прямого тока



Зависимость длины волны максимума спектра от температуры